
	<h2>SI5475BDC-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI5475BDC-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p> <p>Datenblätter:  SI5475BDC-T1-E3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 55074 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	SI5475BDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	55074 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	28 mOhm @ 5.6A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6.3W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1400pF @ 6V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 8V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 12V 6A (Ta) 2.5W (Ta), 6.3W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Ta)

SI5475BDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5475BDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5475BDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5475BDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI5473DC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p>SI5473DC-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p>SI5475BDC-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>	 <p>SI5475DC-T1 VISHAY SI5475DC-T1 VISHAY</p>
 <p>SI5475BDC VISHAY VISHAY SOT23-8</p>	 <p>SI5475DC VISHAY VISHAY SOT23-8</p>	 <p>SI5473DC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 5.9A 1206-8</p>	 <p>SI5475BDC-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 6A 1206-8</p>

SI5475BDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / SI5475BDC-T1-E3 Datenblatt	SI5475BDC-T1-E3-Datenblätter	SI5475BDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5475BDC-T1-E3
SI5475BDC-T1-E3 Electronic	SI5475BDC-T1-E3-Komponenten	SI5475BDC-T1-E3-Verteiler	SI5475BDC-T1-E3-Bild	SI5475BDC-T1-E3-Teil
SI5475BDC-T1-E3 Preis	SI5475BDC-T1-E3 Hersteller	SI5475BDC-T1-E3 Bild	SI5475BDC-T1-E3 Aktie	SI5475BDC-T1-E3 Inventar
SI5475BDC-T1-E3 Neu	SI5475BDC-T1-E3 Original	SI5475BDC-T1-E3 garantiert	SI5475BDC-T1-E3 RFQ	SI5475BDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited